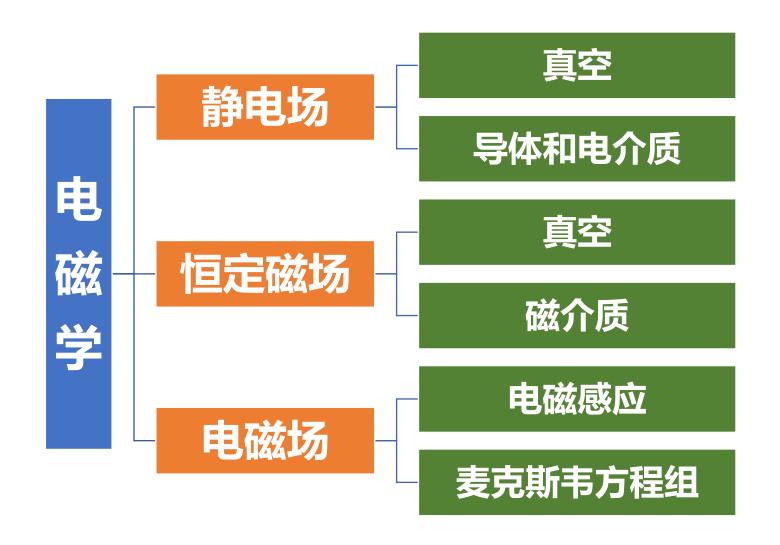
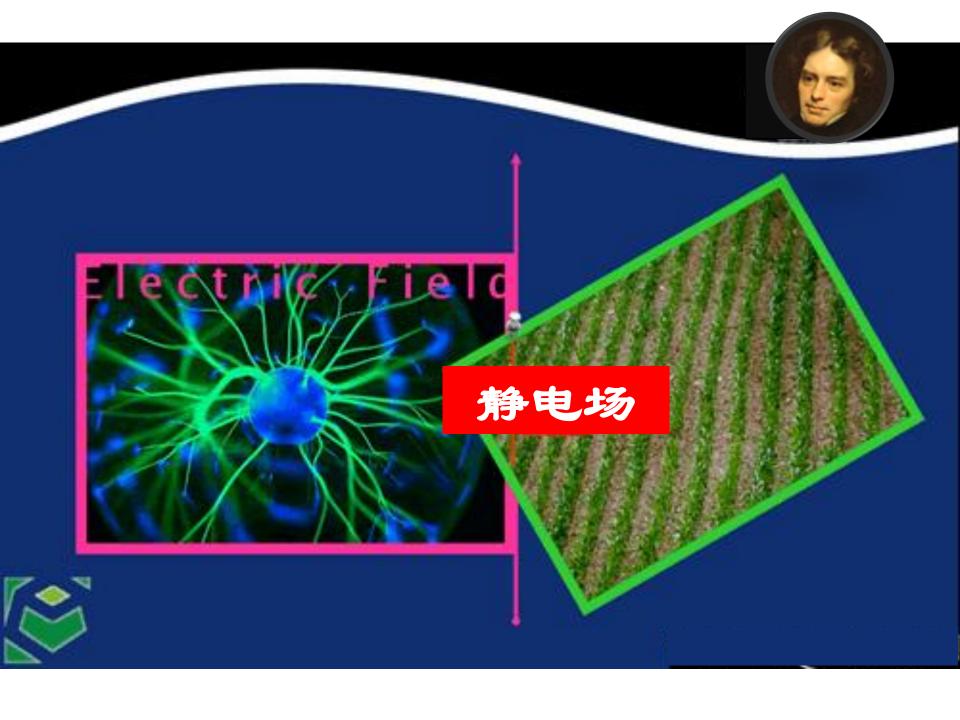


大学物理——电磁学 期末复习

北京理工大学 胡海云





小结
$$egin{align*} & egin{align*} & egin{al$$

小结





静电平衡时 $E_{\rm p}=0$

 $\vec{E}_{ar{k}ar{u}}$ 上表面

或电势: 导体是等势体

表面是等势面

电荷只分布在表面

电介质的极化

电介质中 $E_{\text{内}} \neq 0$

$$\vec{P} = \varepsilon_0 (\varepsilon_{\rm r} - 1) \vec{E}$$

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E} = \varepsilon \vec{E}$$

$$\int_{S} \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_{0 \text{int}}$$

$$\boldsymbol{\sigma}' = \vec{P} \cdot \hat{e}_{\mathrm{n}}$$

电容器的电容 C = Q/U

<u>电容器的电容</u> C = Q/U



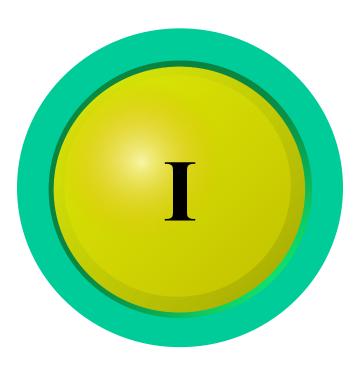
电容器贮存的电场能量

$$W_{\rm e} = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} Q U$$



电场能量密度
$$w_{\rm e} = DE/2 = \varepsilon_0 \varepsilon_{\rm r} E^2/2$$

电场能量
$$W_{\rm e} = \int w_{\rm e} dV = \int \frac{DE}{2} dV$$



1. 库仑定律
$$\vec{F}_{21} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1q_2}{r^2} \hat{e}_{r21}$$
 q_2 q_1 \hat{e}_{r21}

$$q_2$$
 q_1 \hat{e}_{r21}

2. 电力叠加原理 $|\vec{F}| = \sum_i \vec{F}_i$

$$\vec{F} = \sum_i \vec{F}_i$$

$$\vec{E} = \frac{F}{q_0}$$

3. 电场强度定义 $|\vec{E} = \frac{F}{a_0}|$ 单位: N/C or V/m

4. 点电荷的场强公式
$$ar{E} = rac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \hat{e}_r$$

5. 场强叠加原理 $\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i$

$$\vec{E} = \sum_{i} \vec{E}_{i}$$

$$\vec{E} = \int \mathrm{d}\vec{E}$$

一、电荷元场强直接积分法求电场强度

利用电荷元场强公式

如点电荷

无限长均匀带电直线

均匀带电圆环

通过矢量积分求场强

$$\vec{E} = \int_{(Q)} d\vec{E}$$

选好微元,画出 $d\vec{E}$;引入密度,写出 dE。建立坐标,写出分量式;统一变量,写出积分式。定好上、下限、注意对称性;积分求结果、代数求数值。

[1] 一带电细线弯成半径为 R 的半圆形,电荷线密度 $\lambda =$ $\lambda_0 \cos \theta$ 。求圆心 O 处的电场强度。

解:长度为 dl 的圆弧带电荷量为 $dq = \lambda dl = \lambda Rd\theta$, 它在0点产生的场强大小

$$dE = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 R^2} = \frac{\lambda_0 \cos\theta \cdot Rd\theta}{4\pi\varepsilon_0 R^2}$$

分析对称性:关于 y 轴对称的两 电荷元所带电量等值异号,所以 在O点 y方向 $E_v=0$;

$$x$$
 方向 $dE_x = -dE\cos\theta = -\frac{\lambda_0 d\theta}{4\pi\varepsilon_0 R}\cos^2\theta$

$$E_{x} = \int dE_{x} = -\frac{\lambda_{0}}{4\pi\varepsilon_{0}R} \int_{0}^{\pi} \cos^{2}\theta \, d\theta = -\frac{\lambda_{0}}{8\varepsilon_{0}R}$$

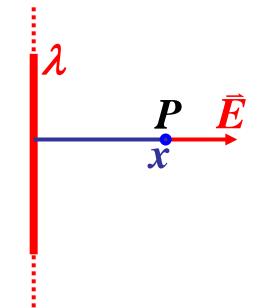
$$\bar{E} = -\frac{\lambda_{0}}{8\varepsilon_{0}R} \hat{i}$$

$$\vec{E} = -\frac{\lambda_0}{8\varepsilon_0 R}\hat{i}$$

典型场的场强表达式

A. 无限长均匀带电直线

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 x}$$



B. 均匀带电圆环(Q, R)轴线上P点

$$\vec{E} = \frac{Q\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 L^2}\hat{i} = \frac{xQ}{4\pi\varepsilon_0 (x^2 + R^2)^{3/2}}\hat{i} - -\left\{\hat{O}\right\} - \frac{P}{XX}$$

C. 无限大均匀带电平面

$$ar{E} = rac{oldsymbol{\sigma}}{2oldsymbol{arepsilon}_0} \hat{e}_{
m n}$$

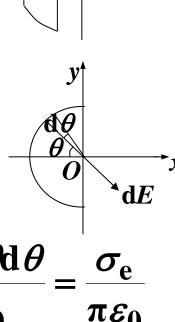
[2] 真空中有半个无限长均匀带电圆柱面,截面半径为 R,电荷面密度为 $\sigma_{\rm e}$,如图所示。求中部轴线上 O 点的电场强度。

解:取其中一条窄条,其电荷线密度 $\lambda_{\rm e} = \sigma_{\rm e} R {
m d} heta$

它在 0 点产生的电场强度大小为

$$dE = \frac{\lambda_{\rm e}}{2\pi\varepsilon_0 R} = \frac{\sigma_{\rm e}Rd\theta}{2\pi\varepsilon_0 R} = \frac{\sigma_{\rm e}d\theta}{2\pi\varepsilon_0}$$

根据对称性,y 方向的分量相互抵消。因此,O点的电场强度为



$$E = E_x = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} dE \cos \theta = 2 \int_0^{\pi/2} \frac{\sigma_e \cos \theta d\theta}{2\pi \varepsilon_0} = \frac{\sigma_e}{\pi \varepsilon_0}$$

场强的方向沿 x 轴正向。

[3] 一半径为 R 的半球面,均匀地带有电荷,电荷面密度 为 σ 。求球心处的电场强度的大小。

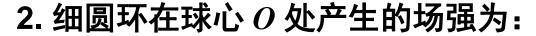
解: 1. 取细圆环:

半径:
$$r = R \sin \theta$$

宽为:
$$dl = Rd\theta$$

面积:
$$dS = 2\pi r dl$$

带电荷:
$$dq = \sigma dS = 2\pi R^2 \sigma \sin \theta d\theta$$



$$dE = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 R^2} \cos\theta$$
 方向如图

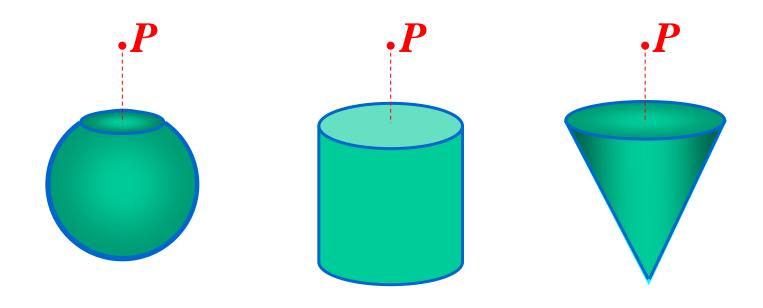
3. 积分:
$$E = \int dE = \int_{0}^{\pi/2} \frac{\sigma}{2\varepsilon_{0}} \sin\theta \cos\theta d\theta = \frac{\sigma}{4\varepsilon_{0}}$$

或写成矢量形式:
$$\vec{E} = -\frac{\sigma}{4\varepsilon_0}\hat{j}$$
 方向沿 y 轴反方向

 $\mathrm{d}E$

 $d\theta$

推广示例:

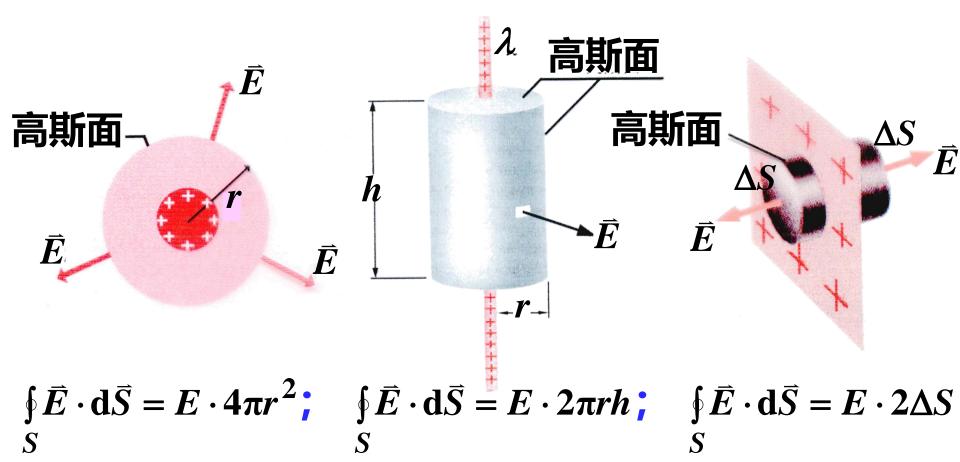


应用高斯定理求解电场强度

在电荷分布有某种对称性时,通过高斯定理求场强。

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \sum q_{\rm int} / \varepsilon_0$$

常见的三种高斯面的选取:



例: 半径为 R 的无限长圆柱形带电体,电荷体密度为 $Ar(r \le R)$, r 为距轴线距离, A 为常数。计算圆柱体内外各点的电场强度。

解:根据高斯定理
$$2\pi r l E = q_{
m int}/arepsilon_0$$

柱内
$$q_{\text{int}} = \int_0^r Ar' 2\pi r' l dr' = \frac{2}{3}\pi A l r^3$$

$$E = \frac{1}{3\varepsilon_0} Ar^2 \qquad (r < R)$$

柱外
$$q_{\text{int}} = \int_0^R Ar' 2\pi r' l dr' = 2\pi A l R^3 / 3$$

$$E = \frac{AR^3}{3\varepsilon_0 r} \qquad (r > R)$$



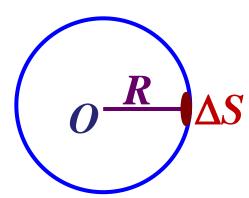


电场强度的计算

一、电荷元场强直接积分法 $ar{E} = \int \mathrm{d}ar{E}$

- 二、应用高斯定理求解 $\int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \sum q_{\rm int} / \varepsilon_0$
- 三、补偿(叠加)法

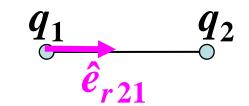
如图所示,真空中一半径为 R 的均匀带电球面,总电荷量为 Q (Q < 0)。今在球面上挖去一块非常小的面积 ΔS (连同电荷),且假设不影响原来的电荷分布,则挖去 ΔS 后球心处电场强度的大小 $E = Q\Delta S/(16\pi^2\varepsilon_0R^4)$,其方向为_由 ΔS 指向球心 O 点。



静电场力

- 1. 点电荷:
- A. 库仑定律

$$\vec{F}_{21} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{21}^2} \hat{e}_{r21}$$



+ 电力叠加原理

$$\vec{F} = \sum_{i} \vec{F}_{i} = \sum_{i} \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \frac{q_{0}q_{i}}{r_{0i}^{2}} \hat{e}_{r0i}$$

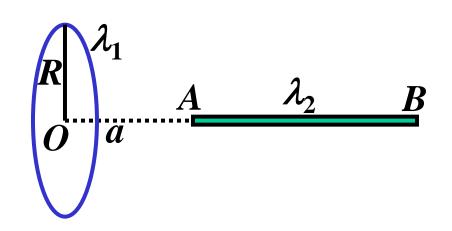
B. 由场强求

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

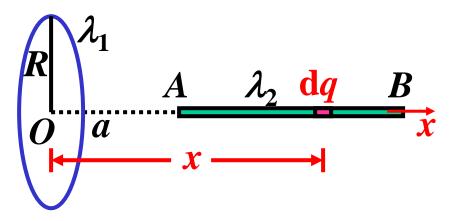
2. 任意带电体: 点电荷元 $d\vec{F} = \vec{E}dq$

$$\vec{F} = \int_{Q} \mathbf{d}\vec{F} = \int_{Q} \vec{E} \mathbf{d}q$$

均匀带电圆环,半径为 R, 电荷线密度为 λ_1 ,其轴线上放一长为 L,电荷线密度为 λ_2 的均匀带电直线,AO = a,如图所示。求: 直线段 AB 受的电场力。



求:均匀带电圆环 (R, λ_1) 轴线上的均匀带电直线 (L, λ_2) 受的电场力。



解: (1) 分割 AB, 取电荷元 $dq = \lambda_2 dl$

(2) d
$$q$$
 所在处场强: $\vec{E} = \frac{2\pi R \lambda_1 x}{4\pi \varepsilon_0 (x^2 + R^2)^{3/2}} \hat{i}$

dq 所受电场力: $d\vec{F} = \vec{E}dq$

(3) 计算:
$$F = \int_{\mathcal{Q}} dF = \int_{a}^{a+L} \frac{\lambda_{1}\lambda_{2}Rx}{2\varepsilon_{0}(x^{2} + R^{2})^{3/2}} dx$$
$$= \frac{\lambda_{1}\lambda_{2}R}{2\varepsilon_{0}} \left\{ \frac{1}{(a^{2} + R^{2})^{1/2}} - \frac{1}{[(a+L)^{2} + R^{2}]^{1/2}} \right\}$$
$$\lambda_{1} = \lambda_{2} \text{ 同号时,方向向右}$$

平行板电容器极板面积为 S,充电至带电 Q 后,两极板之间的静电吸力的大小 F_e 为

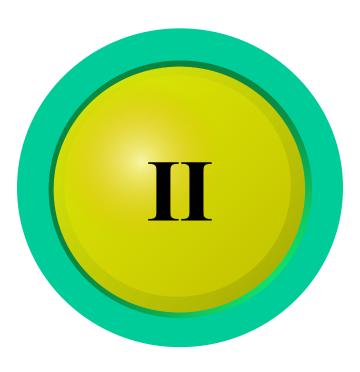
$$\frac{2Q^2}{\varepsilon_0 S}$$

$$\frac{Q^2}{\varepsilon_0 S}$$

$$\bigcirc \frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}$$

$$\bigcirc \frac{Q^2}{4\varepsilon_0 S}$$





一、静电场环路定理
$$\int \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$
 $L(任意)$

定义
$$\varphi = \frac{W_e}{q_0}$$

1. 利用电势定义,

$$\varphi = \sum \varphi_i$$
; $\varphi = \int d\varphi$ (1) 选电荷元;

电势零点
$$oldsymbol{arphi}_P = \int ar{E} \cdot \mathbf{d} ar{l} \ ^{(P)}_{egin{subarray}{c} (P)_{egin{subarray}{c} (P)_{egin{subarray}$$

步骤:

- (1) 先算场强
- (2) 选择合适的路径
- (3) 积分(计算)

步骤:

- (2) 电荷元电势;
- (3) 叠加。

求均匀带电球体的电势分布,并画 φ —r 曲线。 设球体总带电荷量为 q,半径为 R。

解: 由高斯定理可求得场强分布为

$$\vec{E} = \begin{cases}
\frac{q\vec{r}}{4\pi\varepsilon_0 R^3} & (r \le R) \\
\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \hat{e}_r & (r \ge R)
\end{cases}$$

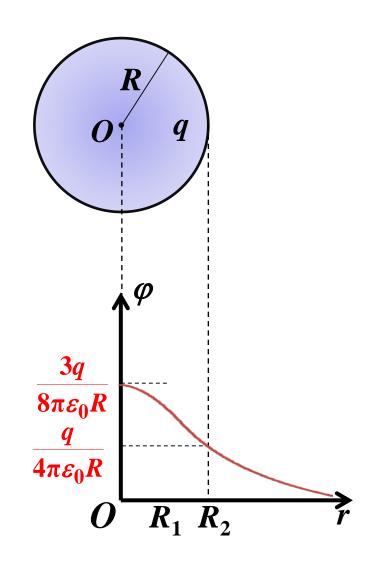
由电势的定义式 $\varphi = \int \vec{E} \cdot d\vec{l}$ 求得电势分布

当
$$r \le R$$
 时, $\varphi = \int_{r}^{\infty} E dr = \int_{r}^{R} \frac{qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3} dr + \int_{R}^{\infty} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr$

$$=\frac{q}{8\pi\varepsilon_0}\left(\frac{3}{R}-\frac{r^2}{R^3}\right)=\frac{q(3R^2-r^2)}{8\pi\varepsilon_0R^3}$$

当
$$r \ge R$$
时, $\varphi = \int_{r}^{\infty} E dr = \int_{r}^{\infty} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$

 $\varphi-r$ 曲线如图所示:



如图所示,一锥顶角为 θ 的圆台,上下底面半径分别为 R_1 和 R_2 ,在它的侧面上均匀带电,电荷面密度为 σ 。 求顶点 θ 的电势。

解: 以顶点 O 作坐标原点,在任意位置 l 处宽度为 dl 的小圆环,其面积为 $dS = 2\pi r dl = 2\pi l \sin \theta dl$

其上电荷量为 $dq = \sigma dS = 2\pi \sigma l \sin \theta dl$

它在 O 点产生的电势为 $\mathrm{d}\varphi = \frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 l} = \frac{\sigma\sin\theta\,\mathrm{d}l}{2\varepsilon_0}$ 则 O 点的总电势为

$$\varphi = \int d\varphi = \frac{\sigma \sin \theta}{2\varepsilon_0} \int_{l_1}^{l_2} dl = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} (R_2 - R_1)$$

真空中,一半径为 R 的均匀带电球面,总电荷量为 Q。今在球面上挖去很小一块面积 ΔS (连同其上电荷),若电荷分布不改变,则挖去小块后球心处电势(设无穷远电势为零)为

1. 求解电场强度的方法:

(1) 利用点电荷或电荷元场强公式和场强叠加原理,通过 矢量积分求场强。

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \hat{e}_r \qquad \qquad \vec{E} = \int_{(Q)} d\vec{E}$$

(2) 在电荷分布有某种对称性条件下,通过高斯定理求场强。

2. 求解电势的方法:

(1) 利用电势定义,利用场强积分法。

$$\varphi_P = \int_P^{\mathbf{z} \cdot \mathbf{L}} \vec{E} \cdot \mathbf{d}\vec{l}$$

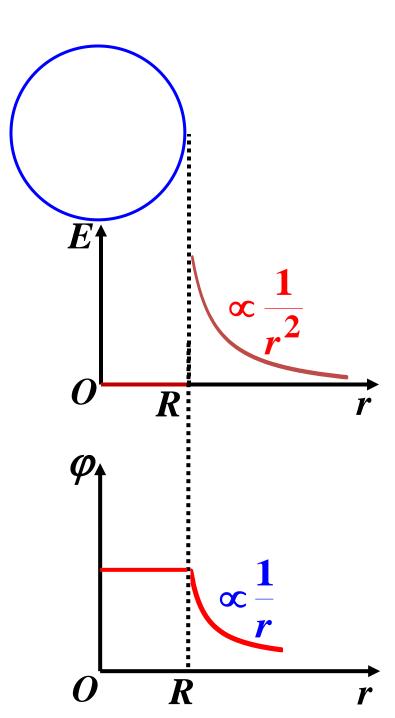
(2) 电势叠加法。

$$\varphi = \int_{(O)} \mathrm{d}\varphi$$

[例] 均匀带电球面 (Q, R)

$$ar{E} = egin{cases} 0 & (r < R) \ rac{Q}{4\piarepsilon_0 r^2} \hat{e}_r & (r > R) \end{cases}$$

$$arphi = \left\{ egin{array}{ll} rac{Q}{4\piarepsilon_0 R} & (r \leq R) \ rac{Q}{4\piarepsilon_0 r} & (r > R) \ \end{array}
ight.$$



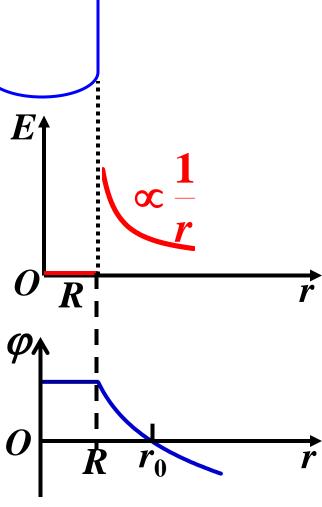
[例] 无限长均匀带电薄壁圆筒 (σ, R) $\sigma = \frac{7}{2\pi R}$

$$egin{aligned} \vec{E} = egin{cases} 0 & (r < R) \ rac{\sigma R}{arepsilon_0 r} \hat{e}_r & = rac{\lambda}{2\pi arepsilon_0 r} \hat{e}_r & (r > R) \end{cases} \end{aligned}$$

选
$$\varphi_{r_0}=0$$

$$\frac{\sigma R}{\varepsilon_0} \ln \frac{r_0}{R} \qquad (r < R)$$

$$\varphi = \begin{cases} \frac{\sigma R}{\varepsilon_0} \ln \frac{r_0}{R} & (r < R) \\ \frac{\sigma R}{\varepsilon_0} \ln \frac{r_0}{r} & (r \ge R) \end{cases}$$



[例] 无限长均匀带电圆柱
$$(\rho, R)$$

$$\bar{E} = \begin{cases} \frac{\rho r}{2\varepsilon_0} \hat{e}_r = \frac{\lambda r}{2\pi\varepsilon_0 R^2} \hat{e}_r & (r < R) \\ \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0 r} \hat{e}_r = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} \hat{e}_r & (r \ge R) \end{cases}$$

选
$$\varphi_{r_0} = 0$$

$$\varphi = \begin{cases} \frac{\rho}{4\varepsilon_0} (R^2 - r^2) + \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0} \ln \frac{r_0}{R} & (r < R) \\ \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0} \ln \frac{r_0}{r} & (r \ge R) \end{cases}$$

三、<u>电势差</u>

$$egin{aligned} U_{12} &= oldsymbol{arphi}_1 - oldsymbol{arphi}_2 &= \int ar{E} \cdot \mathbf{d} ar{l} \ & (P_1)$$
任意路径

[例] 在 xOy 面上倒扣着半径为 R 的半球面上电荷均匀分布,电荷面密度为 σ 。A 点的坐标为(0, R/2),B 点的坐标为(3R/2, 0),求电势差 U_{AB} 。

$$\frac{\sigma}{R}$$
 $\frac{R}{O}$
 $\frac{R}{V}$
 $\frac{C}{V}$
 $\frac{R}{V}$

$$\varphi_A = \frac{1}{2} \varphi_A \underline{\otimes} = \frac{1}{2} \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 R} = \frac{\sigma R}{2\varepsilon_0}$$

Q 整个带电球面的电荷: $\sigma \cdot 4\pi R^2$ $\varphi_B = \frac{1}{2} \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0} \frac{3R}{3} = \frac{\sigma R}{3\varepsilon_0}$

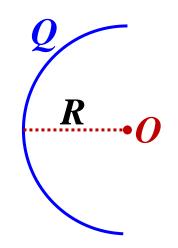
$$U_{AB}=arphi_A-arphi_B=rac{\sigma R}{6arepsilon_0}$$
此题也可从电场的角度考虑 3 $_{\rm D}$

此趣也可然电场的用泛考虑 $U_{AB} = U_{AC} = \frac{1}{2}U_{AC} \stackrel{\text{2}}{=} \frac{1}{2}\int_{A}^{C} \vec{E}_{\frac{\mathbf{E}}{2}} \cdot d\vec{l} = \frac{1}{2}\int_{R}^{2} \frac{Q}{4\pi\varepsilon_{0}r^{2}} dr = \frac{\sigma R}{6\varepsilon_{0}}$

四、电场力的功

$$A_{12} = q \int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} = W_1 - W_2 = q(\varphi_1 - \varphi_2) = qU_{12}$$

真空中有一半径为 R 的半圆细环,均匀带电Q,如图所示。设无穷远处为电势零点,则圆心 O 点处的电势 $\varphi_0 = \frac{Q/4\pi\varepsilon_0 R}{Q}$,若将一电荷量为 q 的点电荷从无穷远处移到圆心 O 点,则电场力做功 $A = \frac{-qQ/4\pi\varepsilon_0 R}{Q}$ 。



五、电势能

• 点电荷 q_0 在电场中的电势能为 $W_e = q_0 \varphi$

氢原子中电子:
$$W_{\rm e} = -\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

● 任意带电体在电场中的电势能为 $W_e = \int \varphi \, dq$

[例] 如图所示,一半径为R的均匀带电球面,电荷量为Q,沿半径方向有一均匀带电细线,电荷线密度为 λ ,长度为l,细线近端离球心的距离为l。设球和细线上的电荷分布固定,求细线在电场中的电势能。

解: 均匀带电球面在球面外各点产生的电势为

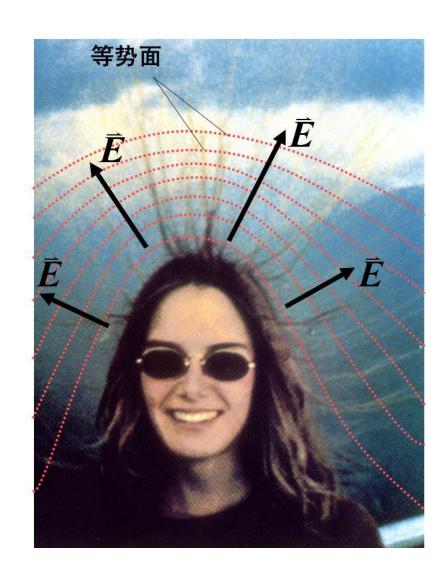
$$\varphi = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

取如图所示的坐标系,均匀带电细线在此电场中的电 势能

$$W_{e} = \int \varphi dq = \int_{l}^{2l} \frac{Q\lambda dx}{4\pi\varepsilon_{0}x} = \frac{Q\lambda}{4\pi\varepsilon_{0}} \ln 2$$

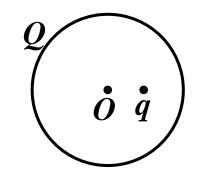
六、电场线与等势面的关系

- 电场线处处垂直等势面
- 电场线指向电势降的方向
- 等势面密的地方场强大



解: 球心0处电势为

$$\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R} + \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R/2} = \frac{Q+2q}{4\pi\varepsilon_0 R}$$



过O点的等势面为以q为中心的球面,故面积为

$$4\pi \left(\frac{R}{2}\right)^2 = \pi R^2$$

七、电场中的电偶极子

电偶极子(\bar{p})在电场(\bar{E})中所受的力矩

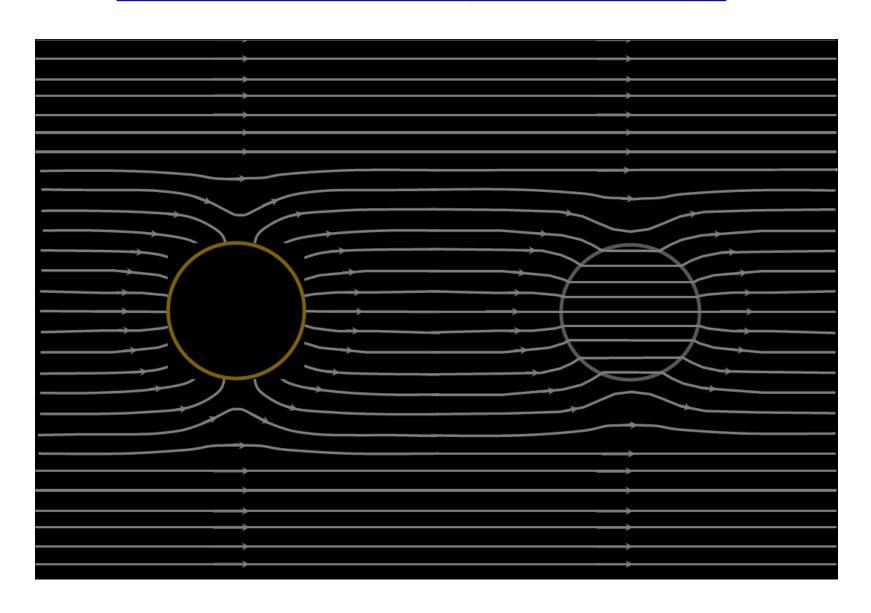
$$\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E}$$

电偶极子(\bar{p})在均匀外场(\bar{E})中的势能

$$W = -\vec{p} \cdot \vec{E}$$

一偶极矩为 \bar{p} 的电偶极子放在场强为 \bar{E} 的均匀外电场中, \bar{p} 与 \bar{E} 的夹角为 α 角。在此电偶极子绕垂直于(\bar{p} , \bar{E})平面的轴沿 α 角增加的方向转过 180° 的过程中,电场力做功 $A=-2p\bar{E}\cos\alpha$

III 静电场中的导体和电介质



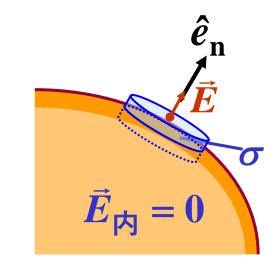
一、静电场中的导体

导体静电平衡的条件

导体内部
$$E_{\text{内}}=0$$
, $\bar{E}_{\overline{\overline{\lambda}}}$ 上表面。
导体成为等势体,表面成为等势面。

静电平衡时导体上电荷的分布

- 1. 导体带电只能在表面!
- 2. 表面附近: $\vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \hat{e}_n$



3. 孤立导体处于静电平衡时,曲率越大的地方 (表面凸出的尖锐部分),面电荷密度也大。

★ 有导体存在时静电场场量的计算原则:

1. 静电平衡的条件

$$E_{\triangleright} = 0$$

or $\varphi = \text{const.}$

2. 基本性质方程

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_{i|D}}{\varepsilon_{0}};$$
 $\oint_{L} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$

3. 电荷守恒定律

$$\sum_{i} Q_{i} = \text{const.}$$

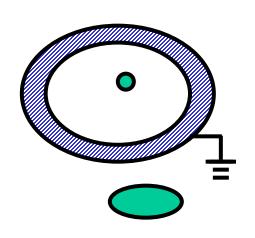
导体静电屏蔽:

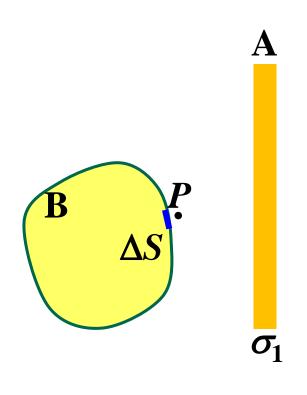
腔内场:

只与内部带电荷量及内 部几何条件及介质有关 (无论接地与否);

腔外场(接地):

只由外部带电荷量和外 部几何条件及介质决定。



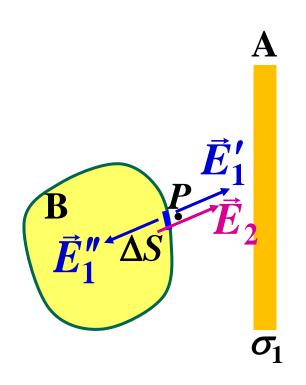


如图所示,电荷面密度为 σ_i 的均 匀带电无限大平板 A 旁边有一带 电导体 B, 今测得 导体 B 表面靠 近 P 点处的电荷面密度为 σ_2 。求: (1) P 点处的电场强度: (2) 导体 B 表面靠近 P 点处的电荷元 $\sigma_2\Delta S$ 所受的电场力?

解: (1) P 点处的场强大小为

$$E_P = \sigma_2/\varepsilon_0$$

方向垂直于导体表面。



(2) ΔS 所带电荷在其两侧产生

$$\vec{E}_1' = -\vec{E}_1'' = \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0}\hat{e}_n$$

除 ΔS 外的其它电荷在 ΔS 附近产生 \vec{E}_2

$$\vec{E}_2 = \vec{E}_1' = -\vec{E}_1'' = \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0}\hat{e}_n$$

导体 B 表面靠近 P 点处的电荷元 $\sigma_2\Delta S$ 所受的电场力

$$F = \sigma_2 \Delta S E_2 = \sigma_2 \Delta S \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} = \frac{\sigma_2^2}{2\varepsilon_0} \Delta S$$

方向垂直于导体表面指向导体外部。

 $A \times B$ 为两导体大平板,面积均为 S,平行放置,如图所示。A 板带电荷 $+Q_1$,B 板带电荷 $+Q_2$,如果使 B 板接地,则 AB 间电场强度的大小 E 为

$$\frac{Q_1}{2\varepsilon_0 S}$$
°

$$\frac{Q_1}{\varepsilon_0 S}$$
°

$$\bigcirc \frac{Q_1 + Q_2}{2\varepsilon_0 S}$$



一 "无限大" 空气平板电容器,极板 A 和 B 的面积都是 S,两极板间距为 d。联接电源后 A 板电势 $\varphi_A = V$, B 板电势 $\varphi_B = 0$ 。现将一所带电荷量为 q、面积也为 S 而厚度可忽略不计的导体片 C 平行的插在两极板中间位置(如图所示),则 C 片的电势 $\varphi_C =$ ______。

解: 设导体片 C 两面带 Q_1 、 Q_2 ,

则AC、CB间场强分别为(向下为正)

$$E_1 = \frac{-Q_1}{\varepsilon_0 S}$$
; $E_2 = \frac{Q_2}{\varepsilon_0 S}$
$$\begin{cases} V = \frac{-Q_1}{\varepsilon_0 S} \frac{d}{2} + \frac{Q_2}{\varepsilon_0 S} \frac{d}{2} \\ q = Q_1 + Q_2 \end{cases}$$
 联立解出 Q_1 、 Q_2 ,则

$$\varphi_{\mathbf{C}} = \frac{Q_2}{\varepsilon_0 S} \frac{d}{2} = \frac{1}{2} \left(V + \frac{qd}{2\varepsilon_0 S} \right)$$

半径为 R、圆心位于 O 点的导体球所带电荷量为 Q。将所 带电荷量为 q (> 0) 的点电荷放在导体球外距球心 O 点为 x(x>R)处,如图所示。P 点在点电荷 q 与球心 O 的连线 上,且 OP = R/2。求: (1) O 点的场强和电势; (2) 导体 球上电荷在 P 点激发电场的场强和电势。

解: (1) 根据静电平衡条件,0 点的场强为零。

球心
$$O$$
 点的电势为
$$\varphi_O = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R} + \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 x}$$

$$Q = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R} + \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 x}$$

(2) 根据静电平衡条件,P 点总的电场强度为零。所求 场强等于总场强减去球外点电荷 q 产生的场强。

$$E_P' = 0 - \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 \left(x - \frac{R}{2}\right)^2}$$

方向沿球心O与点电荷q的连线,向右指向点电荷。

P 点的电势是导体球面上非均匀分布的电荷及球外点电荷 q 所共同产生的,于是,所求电势等于总电势减去球外点电荷 q 产生的电势。

导体达到静电平衡后,P点的电势与O的电势相等,即

$$\varphi_P = \varphi_O = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R} + \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 x}$$

导体球上电荷在 P 点激发电场的电势

$$\varphi_P' = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R} + \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 x} - \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 \left(x - \frac{R}{2}\right)}$$

二、静电场中的电介质

电位移矢量
$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

単位 C/m²

 \underline{D} 的高斯定理 $\int_{S} \overline{D} \cdot d\overline{S} = \sum q_{0 \text{int}}$

各向同性、线性电介质

$$\vec{D}$$
 的高斯定理 $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_{0 \text{int}}$

 D 与 **E** 的 关系
$$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E} = \varepsilon \vec{E}$$

$$\bar{P} \to \bar{E}$$
 的关系 $\bar{P} = \varepsilon_0(\varepsilon_{\rm r} - 1)\bar{E}$

 σ' 与 \bar{P} 的关系

$$\sigma' = \vec{P} \cdot \hat{e}_{n}$$

q'与 σ '的关系 $q' = \int \sigma' dS$

$$q' = \int \sigma' dS$$

 q_{0int} 当自由电荷 q_{0int} 和电介质分布具 一定对称性时, 应用⊅高斯定理 便于解决问题。

[例] 两个同心的薄金属球壳,内、外球壳半径分别为 R_1 和 R_2 。球壳间充满两层均匀电介质,它们的相对介电常数分别为 \mathcal{E}_{r1} 和 \mathcal{E}_{r2} ,两层电介质的分界面半径为R。设内球壳带电荷量为 Q,求:

- (1) \vec{D} 和 \vec{E} 的分布;
- (2) 两球壳之间的电势差;
- (3) 贴近内金属壳的电介质表面上的束缚电荷面密度。

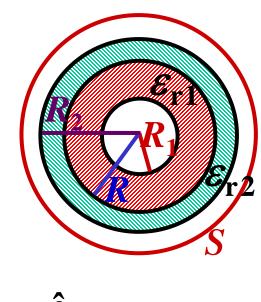
解:
$$(1)$$
 由 \bar{D} 的高斯定理可得

$$r < R_1: \qquad D = 0$$

$$r>R_1: \qquad ar{D}=rac{Q}{4\pi r^2}\hat{e}_n$$
再由 $ar{E}=ar{D}/arepsilon_0arepsilon_{f r}$ 可得

 $r < R_1$: E = 0

$$R_1 < r < R : \vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_{r1}r^2} \hat{\epsilon}$$



$$R < r < R_2 : \vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_{r2}r^2}\hat{e}_r$$

$$r > R_2:$$
 $\bar{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{e}_r$

(2) 两球壳之间的电势差为

$$U = \int_{R_1}^R E \mathrm{d}r + \int_R^{R_2} E \mathrm{d}r$$

$$= \int_{R_1}^{R} \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon_{r1} r^2} dr + \int_{R}^{R_2} \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon_{r2} r^2} dr$$

$$= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{\varepsilon_{r1}R_1} - \frac{1}{\varepsilon_{r1}R} + \frac{1}{\varepsilon_{r2}R} - \frac{1}{\varepsilon_{r2}R_2} \right)$$

(3)
$$\vec{P} = \varepsilon_0(\varepsilon_{r1} - 1)\vec{E}$$

$$\sigma' = \vec{P} \cdot \hat{e}_n = -\varepsilon_0(\varepsilon_{r1} - 1)E = -\varepsilon_0(\varepsilon_{r1} - 1)\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_{r1}r}$$

电容器

电容的计算方法 设
$$\pm Q \to \vec{E} \to U_{\pm} \to C = Q/U$$
 串联: $\frac{1}{C} = \sum \frac{1}{C_i}$ 并联: $C = \sum C_i$

$$C = 4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r R$$

平板电容器
$$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{d} = \frac{\varepsilon S}{d}$$

柱形电容器
$$C = \frac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r l}{\ln(R_2/R_1)}$$

球形电容器
$$C = 4\pi\varepsilon_0\varepsilon_{\rm r} \frac{R_2R_1}{R_2 - R_1}$$

能量
$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} CU^2$$

$$W_{\rm e} = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} Q U$$

电场能量密度

$$w_{\rm e} = DE/2 = \varepsilon_0 \varepsilon_{\rm r} E^2/2$$

电场能量

$$W_{\rm e} = \int w_{\rm e} dV = \int \frac{DE}{2} dV$$

平行板电容器充电后,

板面积、间距变化、插入电介质或金属板,板间 电场及能量的变化;

去掉(不去掉)电源,板间电场及能量的变化。

- 例 一柱形电容器的两极分别为半径为 R_1 的无限长导体圆柱和半径为 R_3 的无限长导体圆筒。两导体共轴,其间充以两层均匀电介质。内、外两层介质的相对介电常数分别为 \mathcal{E}_{r1} 和 \mathcal{E}_{r2} ,分界面的半径是 R_2 ,如图所示。
 - (1) 计算该电容器单位长度的电容;
 - (2) 若两极间电压为U,求电容器单位长度储存的能量。
- 解: (1) 设导体圆柱带电的电荷线密度为 λ ,则内层电介质中的电场强度大小为

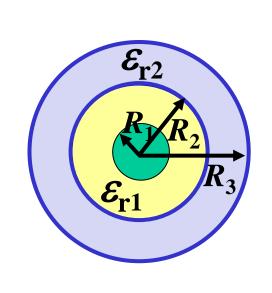
$$E_1 = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_{r1}r} \quad (R_1 < r < R_2)$$

外层电介质中的电场强度大小为

$$E_2 = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_{r2}r} \ (R_2 < r < R_3)$$

两导体间的电势差为

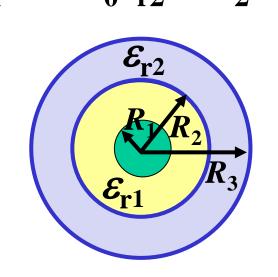
$$U = \int_{R_1}^{R_2} E_1 dr + \int_{R_2}^{R_3} E_2 dr = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_0 \varepsilon_{r1} r} dr + \int_{R_2}^{R_3} \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_0 \varepsilon_{r2} r} dr$$



$$U = \int_{R_1}^{R_2} E_1 dr + \int_{R_2}^{R_3} E_2 dr = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_{r1}r} dr + \int_{R_2}^{R_3} \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_{r2}r} dr$$
$$= \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_{r1}} \ln \frac{R_2}{R_1} + \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_{r2}} \ln \frac{R_3}{R_2}$$

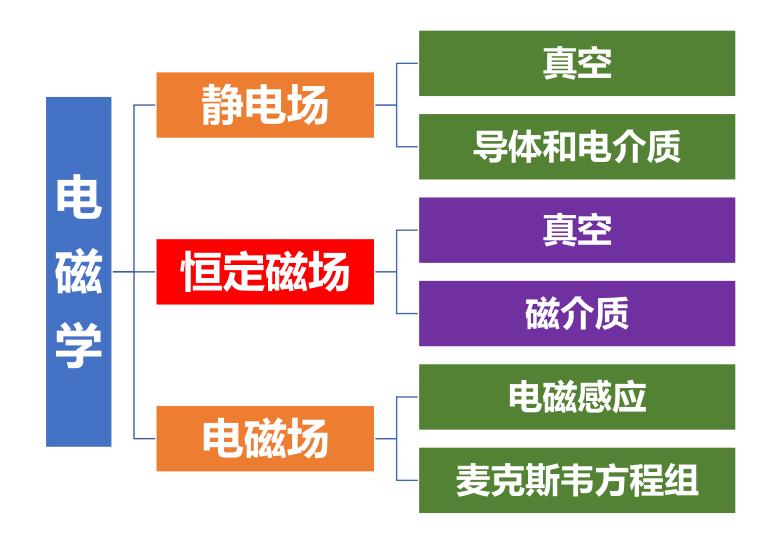
则电缆单位长度的电容为

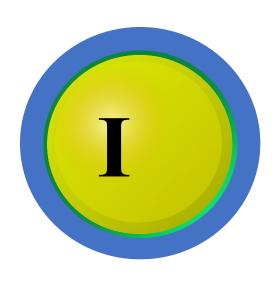
$$C = \frac{\lambda}{U} = \frac{2\pi\varepsilon_0}{\frac{1}{\varepsilon_{r1}} \ln \frac{R_2}{R_1} + \frac{1}{\varepsilon_{r2}} \ln \frac{R_3}{R_2}}$$



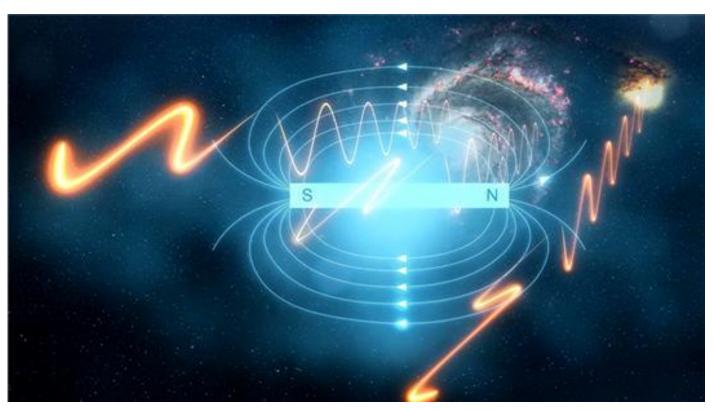
(2) 电容器单位长度储存的静电能为

$$W_{e} = \frac{1}{2}CU^{2} = \frac{\pi\varepsilon_{0}}{\frac{1}{\varepsilon_{r1}}\ln\frac{R_{2}}{R_{1}} + \frac{1}{\varepsilon_{r2}}\ln\frac{R_{3}}{R_{2}}}U^{2}$$





磁感应强度图的计算



磁感应强度图的计算

$$\mathbf{d}\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I\mathbf{d}\vec{l} \times \hat{e}_r}{r^2}$$

ullet 有限长载流直导线的磁感应强度 $ar{B}$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \varphi_1 - \cos \varphi_2)$$

方向:右手法则

(理解各量的意义)



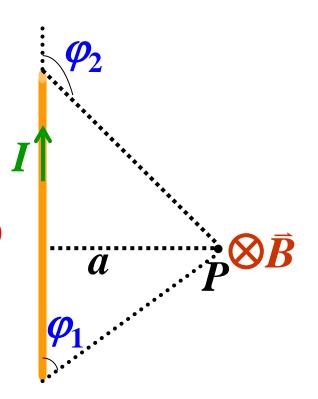
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

半无限长直导线端点外

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}$$

场点在直电流或它的延长线上

$$B = 0$$



圆电流的中心轴线上的磁场

$$B = \frac{\mu_0}{2} \frac{IR^2}{(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

(1) 方向: 右手定则

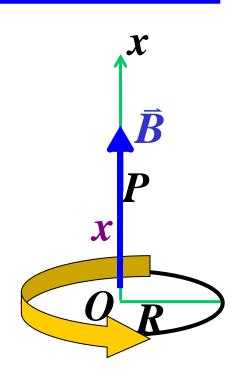
(2)
$$x = 0$$
 圆心处 $B = \frac{\mu_0 I}{2 B}$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

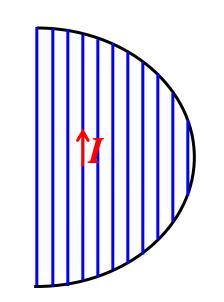
$$1/n$$
 电流圆弧的圆心 $B = \frac{\mu_0 I}{2nR}$

(3)
$$x >> R$$

$$B = \frac{\mu_0}{2} \frac{IR^2}{x^3}$$



[例] 如图所示,半径为 R 的木球上绕有细导线,所有线圈依次紧密排列,单层盖住半个球面,共有 N 匝。设导线中电流为 I,求球心处的磁感应强度。

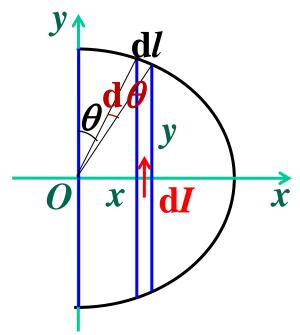


解:建立如图所示的坐标系 Oxy。

在坐标 x 处取半径为 y, 宽为 dl 的元电流(窄圆环), 其所在处球面半径与 y 轴夹角为 θ 。

窄圆环上的电流匝数为
$$dN = \frac{N}{\pi R/2} dl$$

其上电流为 $dI = I dN = I \frac{N dl}{\pi R/2}$



该窄圆环在圆心 0 处产生的磁感应强度大小为

$$dB = \frac{\mu_0}{2} \frac{dIy^2}{R^3} = \frac{\mu_0 I N dly^2}{\pi R^4}$$

将 $y = R\cos\theta$, $dl = Rd\theta$ 代入

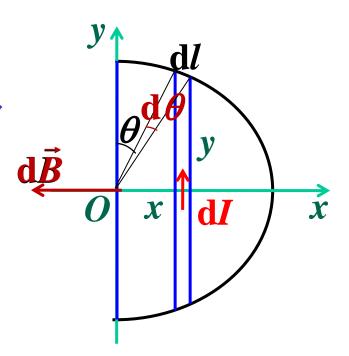
$$dB = \frac{\mu_0 IN}{\pi R} \cos^2 \theta d\theta$$

方向沿 x 轴负向。

0 点的总磁感应强度大小

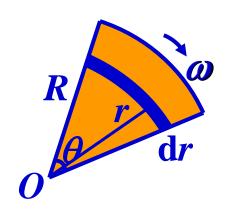
$$B = \int dB = \int_0^{\pi/2} \frac{\mu_0 IN}{\pi R} \cos^2 \theta d\theta = \frac{\mu_0 IN}{4R}$$

方向沿 x 轴负向。



[例] 如图所示,一扇形薄片,半径为 R,张角为 θ ,其上均匀分布正电荷,面密度为 σ 。 薄片绕过顶角 O 点且垂直于薄片的轴转动,角速度为 ω ,求 O 点处的磁感应强度。

解:将扇形分割成许多弧形窄条, 任取其中一半径为 r, 宽为 dr 的窄条,其所带电荷量为



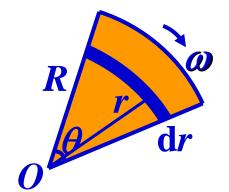
 $dq = \sigma\theta r dr$

解:将扇形分割成许多弧形窄条,任取其中一半径为r,宽为 dr 的窄条,其所带电荷量为

$$dq = \sigma \theta r dr$$

旋转时,相当于一圆电流

$$dI = \frac{dq}{T} = \frac{dq}{2\pi / \omega} = \frac{\omega \sigma \theta r dr}{2\pi}$$



圆电流 dI 在 O 点处的磁感应强度大小为

$$dB = \frac{\mu_0 dI}{2r}$$

整个扇形薄片在 O 点处的磁感应强度大小为

$$B = \int_0^R dB = \frac{\mu_0 \omega \sigma \theta R}{4\pi} \otimes$$

磁感应强度的计算

毕-萨定律
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \hat{e}_r}{r^2}$$

<u>磁场叠加原理</u> $\vec{B} = \int d\vec{B}$

 $\frac{\mathbf{安培环路定理}}{\mathbf{S}} \int_{I} \mathbf{B} \cdot \mathbf{d}\mathbf{l} = \mu_0 \sum_{i} I_{i}$ 十

对称性

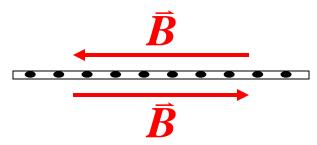
<u>典型电流</u> 分布的磁场

几种典型电流的 $\bar{B}(1)$

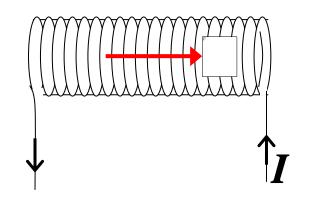
安培环路定理的应用结果

1. 无限大载流平面磁场

$$B = \frac{\mu_0 i}{2}$$



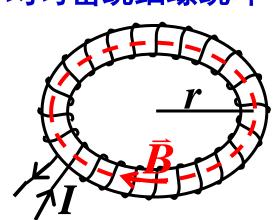
2. "无限长"载流密绕直螺线管



$$\begin{cases} B_{|\mathcal{A}|} = \mu_0 nI \\ B_{|\mathcal{A}|} = 0 \end{cases}$$

方向:右手法则

3. 均匀密绕细螺绕环



$$egin{cases} B_{
ho} = \mu_0 rac{N}{2\pi r} I \ B_{
ho} = 0 \end{cases}$$

方向:右手法则

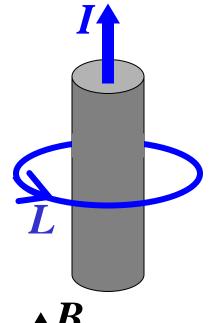
几种典型电流的B(2)

—— 安培环路定理的应用结果

4. "无限长"载流薄圆筒

方向:右手法则

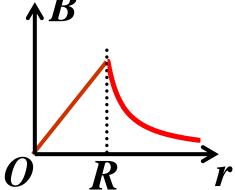
$$\begin{cases} B_{|\mathcal{P}|} = 0 \\ B_{|\mathcal{P}|} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \end{cases}$$



5. "无限长"载流圆柱体

方向:右手法则

$$B_{
ho} = rac{\mu_0 r}{2\pi R^2} I$$
 $P = rac{\mu_0 r}{\mu_0 I}$



如图所示,一半径为 R 的均匀带电无限长直圆筒,面电荷密度为 σ 。该筒以速度 ω 绕其轴线匀速旋转。试求圆筒内部的磁感应强度。

解:如图所示,圆筒旋转时相当于 圆筒上具有同向的面电流密度 (单位长度的电流强度)*i*:

$$i = 2\pi R \sigma \omega / (2\pi) = R \sigma \omega$$

其中, $2\pi R\sigma$ 是单位长度的电荷量。

可得
$$B = \mu_0 i = \mu_0 R \sigma \omega$$

当 $\sigma > 0$ 时,方向平行于轴线向右。

如图所示,一无限长同轴电缆,内导体圆柱的半径为 R_1 ,外导体的内、外半径分别为 R_2 和 R_3 。电流 I_0 流入内导体圆柱的横截面,并沿外导体流回,但电流密度沿径向线性变化: $j_1 = C_1 r$ (内导体), $j_2 = C_2 r$ (外导体)。

试计算以下各处的磁感应强度:

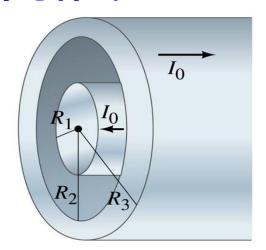
(1)
$$r < R_1$$
; (2) $R_1 < r < R_2$;

(3)
$$R_2 < r < R_3$$
; (4) $r > R_3$.

解: 在内导体圆柱中

$$I_0 = \int_0^{R_1} j_1 2\pi r dr = 2\pi C_1 \int_0^{R_1} r^2 dr = \frac{2\pi C_1 R_1^3}{3}$$

因此
$$C_1 = \frac{3I_0}{2\pi R_1^3}$$



在外导体圆筒中

$$I_0 = \int_{R_2}^{R_3} j_2 2\pi r dr = 2\pi C_2 \int_{R_2}^{R_3} r^2 dr = \frac{2\pi C_2 (R_3^3 - R_2^3)}{3}$$

送此
$$C_2 = \frac{3I_0}{2\pi(R_3^3 - R_2^3)}$$

根据安培环路定理有

$$\oint_{L} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_{L} B dl = 2\pi r B = \mu_{0} \sum_{|\gamma|} I_{|\gamma|}$$

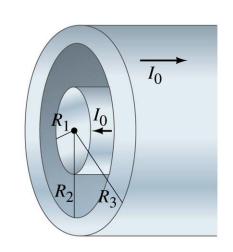
(1)
$$r < R_1$$

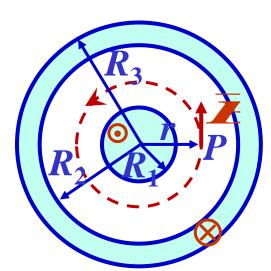
$$\sum I_{\beta} = \int_0^r C_1 r 2\pi r dr = \frac{2\pi C_1 r^3}{3}$$

$$B = \frac{\mu_0 C_1 r^2}{3} = \frac{\mu_0 I_0}{2\pi R_1^3} r^2$$

$$(2) R_1 < r < R_2$$

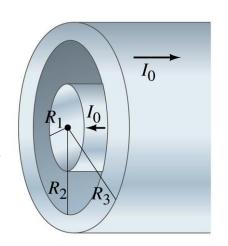
$$\sum I_{\bowtie} = I_{0} \qquad B = \frac{\mu_0 I_0}{2\pi r}$$





(3)
$$R_2 < r < R_3$$

$$\sum I_{\mid j \mid} = I_0 - \int_{R_2}^r C_2 r 2\pi r dr = I_0 - \frac{2\pi C_2 (r^3 - R_2^3)}{3}$$

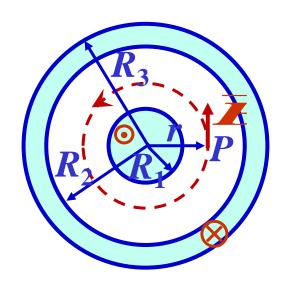


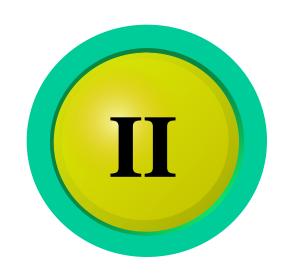
$$B = \frac{\mu_0 I_0}{2\pi r} \frac{R_3^3 - r^3}{R_3^3 - R_2^3}$$

(4)
$$r > R_3$$

$$\sum I_{\bowtie} = 0$$

$$B = 0$$





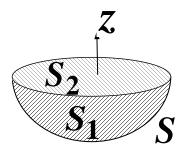
 $\overline{\text{WMD}}$ —— 通过某一面积 S 的磁感应线的总条数

$$\mathbf{\Phi}_{\mathbf{m}} = \int_{S} \mathbf{\vec{B}} \cdot \mathbf{d} \mathbf{\vec{S}}$$

单位: 韦伯 Wb

磁场的高斯定理

$$\oint_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$



$$\begin{split} \boldsymbol{\Phi}_{\mathbf{m}} &= \int_{S_1} \vec{B} \cdot \mathbf{d}\vec{S} = -\int_{S_2} \vec{B} \cdot \mathbf{d}\vec{S} \\ &= -\int_{S_2} (a\hat{i} + b\hat{j} + c\hat{k}) \cdot \mathbf{d}S\hat{k} \\ &= -S_2 c \end{split}$$

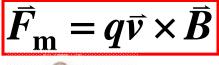


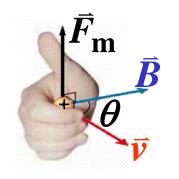
磁力

——与受力电荷运动有关的运动电荷之间相互作用。

磁力

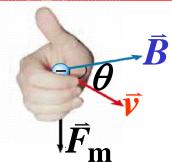
1. 洛伦兹力 —— 运动电荷在磁场中受力:





 $q \bar{v}$ 、 \bar{B} 、 \bar{F} 构成右手系

(注意 q) 为正和负两种情况)



q 在垂直于磁场的平面内做匀速圆周运动,磁力为向心力。

$$R = \frac{mv}{qB}$$

半径 $R \propto v$

$$T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{qB}$$

<u> 周期 *T* 与ν 无关</u>

若 \vec{v} 与 \vec{B} 成 θ 角---q做螺旋线运动。

$$R = \frac{mv\sin\theta}{qB}$$

$$T = \frac{2\pi m}{qB}$$

螺距
$$h = \frac{2\pi m}{qB} v \cos \theta$$

— 电流元在磁场中受力: 2. 安培力

流元在磁场中受力:
$$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$$
 $\vec{F} = \int d\vec{F}$ $Id\vec{l} \setminus \vec{B} \setminus \vec{A}$ 构成右手系 $Id\vec{l} \setminus \vec{B} \setminus \vec{A}$

均匀磁场中弯曲通电导线受的磁力等于从起点到终点连的 直导线通有相同电流时所受磁力。

从安培力角度来看 \vec{B} 的量值的物理意义:

单位电流元在该处所受的最大安培力。

$$B = \frac{\left(\mathrm{d}F_{\mathbf{\Xi}}\right)_{\mathrm{max}}}{I\mathrm{d}l}$$

将一均匀分布着电流的无限大载流平面放入均匀磁场中, 电流方向与此磁场垂直。已知平面两侧的磁感应强度分 别为 \bar{B}_1 和 \bar{B}_2 (如图), 求该载流平面 单位面积所受的磁场力的大小和方向。

解: 载流平面在其两侧产生的磁场

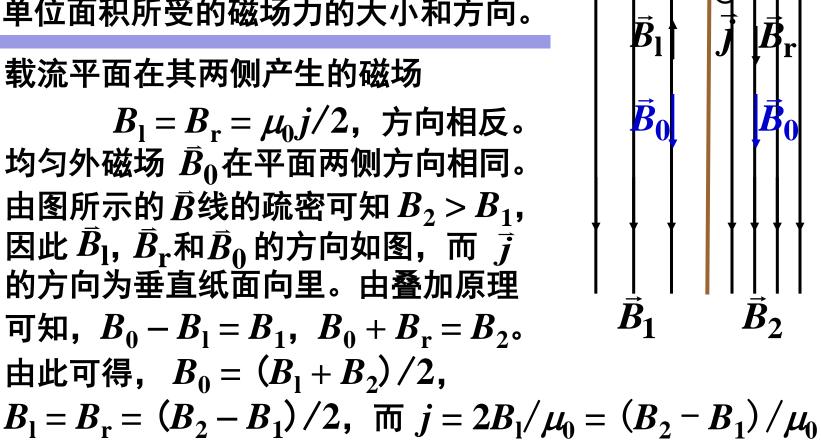
 $B_1 = B_r = \mu_0 j/2$,方向相反。 均匀外磁场 \bar{B}_0 在平面两侧方向相同。 由图所示的 B线的疏密可知 $B_2 > B_1$, 因此 \bar{B}_{l} , \bar{B}_{r} 和 \bar{B}_{0} 的方向如图,而 \bar{j} 的方向为垂直纸面向里。由叠加原理 可知, $B_0 - B_1 = B_1$, $B_0 + B_r = B_2$ 。

由此可得, $B_0 = (B_1 + B_2)/2$,

载流平面单位面积受的力为

$$F = jB_0 = (B_2^2 - B_1^2)/(2\mu_0)$$

方向垂直载流平面指向 \bar{B}_1 一侧。

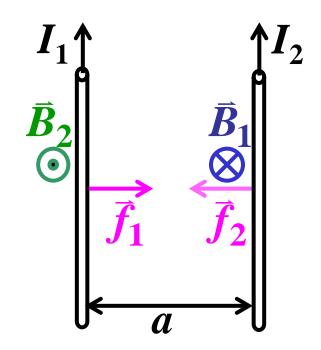


3. 平行电流间的相互作用力

单位长度受力

$$f_1 = I_1 B_2 = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a}$$

$$f_2 = I_2 B_1 = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a}$$

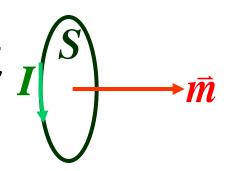


同向相吸, 异向相斥

4. 载流线圈在均匀磁场中受磁力矩: $M = m \times B$

其中磁矩: $\bar{m} = IS\hat{e}_n$

通电平面线圈的磁矩 m 和电流 I 回转方向的右手螺旋关系

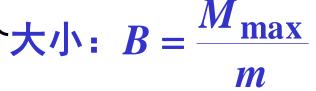


磁感应强度矢量形的另一种定义

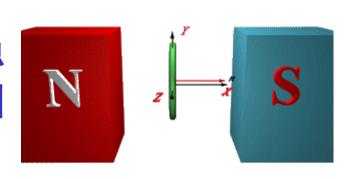
试验载流线圈:

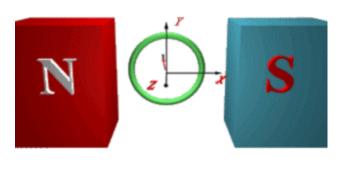
- (1) 几何线度小,面积小,在线圈范围内磁场性质处处相同;
- (2) 电流小,不影响原磁场。

方向: 试验载流线圈稳 定义: B 的法线方向;



具有单位磁矩的载流线 圈所受的最大磁力矩。





[例] 一半径为 R、电荷线密度为 λ 的均匀带电圆环状,以匀角速度 ω 绕其一直径旋转。现将转动圆环置于均匀磁场中,磁感应强度 B 与转轴垂直,求该圆环受到的磁力矩。

$$\mathbf{m} : \mathbf{d}q = \lambda \mathbf{d}l = \lambda R \mathbf{d}\theta$$

$$\mathbf{d}I = \frac{\omega \mathbf{d}q}{2\pi} = \frac{\omega \lambda R \mathbf{d}\theta}{2\pi}$$

$$\mathbf{d}m = \pi r^2 \mathbf{d}I = \frac{\omega \lambda R^3 \sin^2\theta \, \mathbf{d}\theta}{2}$$

$$m = \int \mathbf{d}m = \int_0^{2\pi} \frac{\omega \lambda R^3 \sin^2\theta \, \mathbf{d}\theta}{2} = \frac{\pi \omega \lambda R^3}{2}$$

$$M = mB = \frac{\pi \omega \lambda BR^3}{2}$$
 方向: 当 $\lambda > 0$ 时, \otimes



磁场中的磁介质

<u>磁介质对磁场的影响(长直螺线管内)</u>: $\vec{B} = \mu_{\rm r} \vec{B}_{\rm 0}$

磁导率(μ)、相对磁导率($\mu_{\rm r}$):

 $\mu = \mu_0 \mu_r$

磁介质的分类:

 $\mu_{\rm r} > 1$ 顺磁质; $\mu_{\rm r} < 1$ 抗磁质; $\mu_{\rm r} >> 1$ 铁磁质

$$\underline{\vec{H}}$$
 的环路定理:
$$\int_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_{0|D|}$$

在有磁介质时,一般根据自由电流的对称性分布求 \hat{H} ,

再利用 $\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$ 求 \vec{B} 。

一根同轴线由半径为 R_1 的长直导体柱和套在它外面的内半径为 R_2 、外半径为 R_3 的同轴导体圆筒组成。两导体间绝缘介质的相对磁导率为 μ_r ,如图。传导电流 I 沿内导体向上流去,由圆筒向下流回,在它们的截面上电流都是均匀分布的。求同轴线内外的磁感应强度大小 B 的分布。

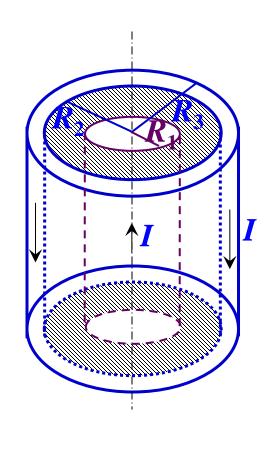
解:由安培环路定理
$$\int \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_i$$
 $0 < r < R_1$ 区域 $2\pi r H = Ir^2/R_1^2$ $H = \frac{Ir}{2\pi R_1^2}$ $B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R_1^2}$ $R_1 < r < R_2$ 区域 $2\pi r H = I$ $H = \frac{I}{2\pi r}$, $B = \frac{\mu_0 \mu_\Gamma I}{2\pi r}$

$$R_2 < r < R_3$$
 区域 $2\pi rH = I - \frac{I\pi(r^2 - R_2^2)}{\pi(R_3^2 - R_2^2)}$

$$H = \frac{I}{2\pi r} \left(1 - \frac{r^2 - R_2^2}{R_3^2 - R_2^2} \right)$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \left(1 - \frac{r^2 - R_2^2}{R_3^2 - R_2^2} \right)$$

$$r > R_3$$
 区域 $H = 0$, $B = 0$



静电场与恒定磁场对照

静电场

恒定磁场

电场强度 \vec{E} 电位移矢量 $\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$ 介电常数 $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$ \vec{E} 通量 $\Phi_e = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$ 电场力(库仑力) $d\vec{F} = dq\vec{E}$

均匀电场中电偶极子 所受的力矩 $\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E}$ 电矩 $\vec{p} = q\vec{l}$ 磁感应强度 \vec{B} 磁场强度 $\vec{H} = \vec{B}/\mu$ 磁导率 $\mu = \mu_0 \mu_r$ 磁通量 $\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$

磁场力

 $ec{F} = q \vec{v} \times \vec{B}$ (洛伦兹力) $\mathrm{d} \vec{F} = I \mathrm{d} \vec{l} \times \vec{B}$ (安培力)

均匀磁场中平面载流线 圈所受的力矩 $\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$

磁矩 $\vec{m} = IS\hat{e}_{n}$

电磁学基本定理

静电场

恒定磁场

$$\mathbf{i}\mathbf{f}$$
 $\int_{S} \vec{D} \cdot \mathbf{d}\vec{S} = \sum q_{0$ 内

 $\mathbf{F} \int_{S} \vec{D} \cdot \mathbf{d}\vec{S} = \sum q_{0}$

无
$$\int_{L} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$
旋

$$\mathcal{F}$$

$$\int_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

源

旋
$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_{0int}$$

静电场

恒定磁场

点电荷
$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{e}_r$$

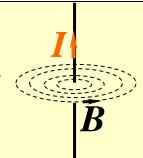
电流元 d
$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \hat{e}_r}{r^2}$$

$$\vec{E} = \int d\vec{E}$$

$$\vec{B} = \int d\vec{B}$$

无限长
$$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$$

五限长
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$



无限大均匀带电平面 σ

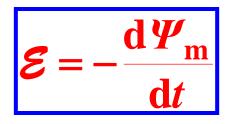
$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

无限大载流平板

$$B = \frac{\mu_0 i}{2}$$



法拉第电磁感应定律 适用于一切产生电动势的回路



在任何电磁感应现象中,只要穿过回路的磁通量变化,回路中就一定有感应电动势产生。若导体回路是闭合的,感应电动势就会在回路中产生感应电流;若导线回路不是闭合的,回路中仍然有感应电动势,但是不会形成电流。

解题步骤:

- 1. 首先任定回路的绕行方向;
- 2. 计算回路面积上的<mark>磁通量</mark>,当磁感线方向与绕 行方向成右手螺旋关系时,规定磁通量为正;
- 3. 应用定律计算感应电动势,规定电动势方向与绕行方向一致时为正。

<u>楞次定律</u>:闭合回路中感应电流的方向,总是使它所激发的 磁场来阻止引起感应电流的磁通量的变化。

法拉第电磁感应定律

$$\mathcal{E} = -rac{\mathbf{d} \Psi_{\mathbf{m}}}{\mathbf{d} t}$$
 适用于一切产生电动势的回路

楞次定律: 闭合回路中感应电流的方向, 总是使它所激发 的磁场来阻止引起感应电流的磁通量的变化。

 $t_2 - t_1$ 内,通过导体回路任一截面的感应电荷量:

$$q = \frac{1}{R} |\boldsymbol{\Phi}_2 - \boldsymbol{\Phi}_1| = \frac{|\Delta \boldsymbol{\Phi}|}{R}$$

$$\mathcal{E}_{ab} = \int_a^b \vec{E}_{ne} \cdot d\vec{l} = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

适用于切割磁感线的导体

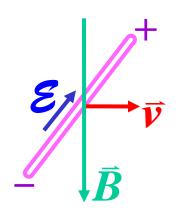
- 解题步骤 1. 任取一线元 $d\bar{l}$
 - 2. 标出 $d\bar{l}$ 处的 \bar{v} 和 \bar{R}
 - 3. $d\mathcal{E} = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = vB \sin\theta \cos\alpha dl$
 - 4. 积分

5. 方向
$$\mathcal{E} > 0$$
, $a \rightarrow b$, $\varphi_b > \varphi_a$ $\mathcal{E} < 0$, $b \rightarrow a$, $\varphi_b < \varphi_a$

动生电动势的方向:

当直导线切割磁力线运动时。

三者 \vec{v} 、 \vec{B} 、 \mathcal{E} 方向的右手法则

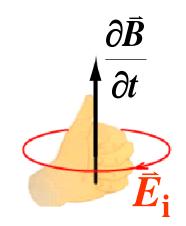


感生电动势与感生电场

感生电动势: 由于磁场随时间变化而引起的感应电动势。

$$\mathbf{\mathcal{E}} = \oint_{L} \vec{E}_{i} \cdot d\vec{l} = -\int_{S} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

S: 是以L为边界的任意面积



感生电场 E_{i} : 因随时间变化的磁场而产生的电场。

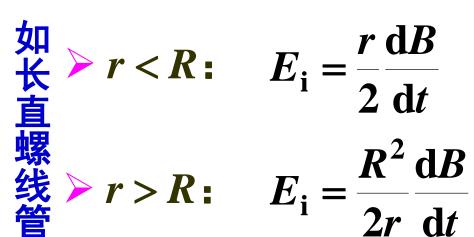
$$\oint_{S} \vec{E}_{i} \cdot d\vec{S} = 0$$

非保守场、涡旋场、无源场

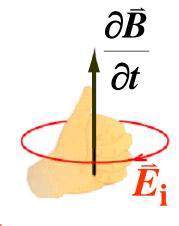
感生电场 \bar{E}_{i} 和感生电动势

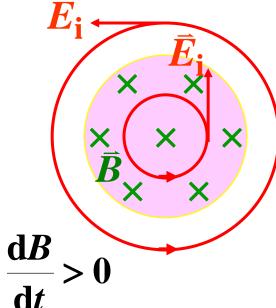
$$\mathcal{E} = \oint_{L} \vec{E}_{i} \cdot d\vec{l} = -\int_{S} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

 E_{i} 具有某种对称性时的计算



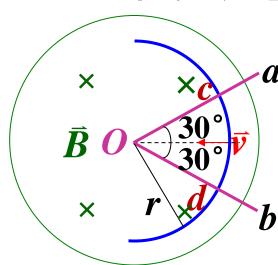
感生电场线闭合成环,图中





在求其它线段内的感生电动势时,可补上半径方向的线段(其上感生电动势为零)构成回路,利用法拉第电磁感应定律去求解。

例 在垂直图面的圆柱形空间内有一随时间均匀变化的匀强 磁场。其磁感强度的方向垂直图面向里。在图面内有两 条相交于 O 点夹角为 60° 的直导线 Oa 和 Ob,而 O 点则 是圆柱形空间的轴线与图面的交点。此外,在图面内另 有一半径为 r 的半圆环形导线在上述两条直导线上以速 度 \vec{v} 匀速滑动。 \vec{v} 的方向与 $\angle aOb$ 的平分线一致。并指向 O 点(如图)。在时刻 t, 半圆环的圆心正好与 O 点重合, 此时磁感强度的大小为 B. 磁感强度大小随时间的变化 率为 k(k) 为一正的常数)。求此时半圆环导线与两条直 线所围成的闭合回路 cOdc 中的感应电动势 \mathcal{E} 。



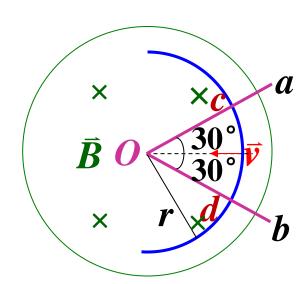
解:取顺时针方向为闭合回路 cdOc 的绕行方向,回路中的感应电动势由感生电动势 \mathcal{E}_1 和动生电动势 \mathcal{E}_2 两部分组成,即 $\mathcal{E} = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2$

 \mathcal{E}_1 由涡旋电场形成,它相当于半圆环导线处于 t 时刻所在位置静止不动时,回路 cdOc 中感应电动势,所以

$$\mathcal{E}_1 = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_{S} \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = -k \, \pi r^2 / 6$$

cd 弧上的动生电动势相当于 cd 弦上的动生电动势,所以

$$\mathcal{E}_2 = \int_c^d (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = vB \overline{cd} = vBr$$



解:取顺时针方向为闭合电路 cOdc 的绕行方向,电路中的感应电动势由感生电动势 \mathcal{E}_1 和动生电动势 \mathcal{E}_2 两部分组成, \mathbf{E}_2

即
$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2$$

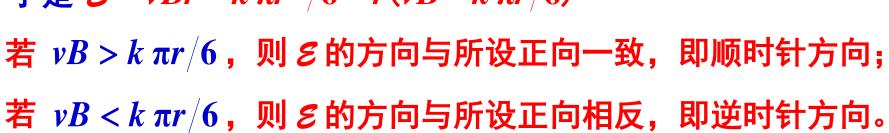
 \mathcal{E}_1 由涡旋电场形成,它相当于半圆环导线处于 t 时刻所在位置静止不动时,回路 cOdc 中感应电动势,所以

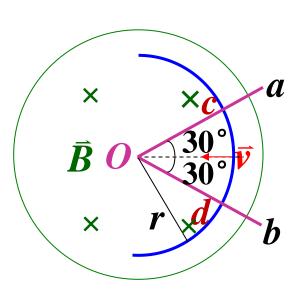
$$\mathcal{E}_1 = -\frac{\mathbf{d}}{\mathbf{d}t} \int_{S} \vec{B} \cdot \mathbf{d}\vec{S} = -k \, \pi r^2 / 6$$

cd 弧上的动生电动势相当于 cd 弦上的动生电动势,所以

$$\mathcal{E}_2 = \int_c^d (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = vB \overline{cd} = vBr$$

于是
$$\mathcal{E} = vBr - k \pi r^2 / 6 = r(vB - k \pi r / 6)$$





[例] 半径为 R 的圆柱形中空长直螺线管垂直于纸面放置,该螺线管单位长度上密绕了 n 匝线圈,线圈中通有 i = kt 的电流 (k 为正的常量,t 为时间),电流流向如图所示。在螺线管外有一无限长直导线平行于纸面放置,试求:

- (1)螺线管内外空间的感生电场强度 $ar{E}_{ar{ ext{R}},ar{ ext{D}}}$ 和 $ar{E}_{ar{ ext{R}},ar{ ext{O}}}$ 。
- (2) 长直导线中的感应电动势 ε 的大小,并指明其方向。

解: (1) 由无限长和轴对称条件,有

$$\begin{split} \vec{E}_{\vec{\mathbb{R}}} &= \vec{E}_{\vec{\mathbb{R}}}(\vec{r}) \\ \oint \vec{E}_{\vec{\mathbb{R}}} \cdot d\vec{l} &= E_{\vec{\mathbb{R}}} \cdot 2\pi r = -\frac{d\Phi_{\mathbf{m}}}{dt} \\ B &= \mu_0 n i = \mu_0 n k t \end{split}$$
 长直导线

$$r < R$$
: $E_{$ 麼内 \cdot $2\pi r = -\frac{\mathrm{d}\Phi_{\mathrm{m}}}{\mathrm{d}t} = -\pi r^2 \cdot \mu_0 n k$ 得: $\bar{E}_{$ 麼內 $= -\frac{r}{2}\mu_0 n k \hat{e}_{\varphi}$ (沿圆周切向与电流流向相反)

$$r > R$$
: E 感外 $\cdot 2\pi r = -\frac{\mathrm{d}\Phi_{\mathrm{m}}}{\mathrm{d}t} = -\pi R^2 \cdot \mu_0 nk$

得:
$$\vec{E}_{\text{感外}} = -\frac{R^2}{2r} \mu_0 n k \hat{e}_{\varphi}$$
 (沿圆周切向与电流流向相反)

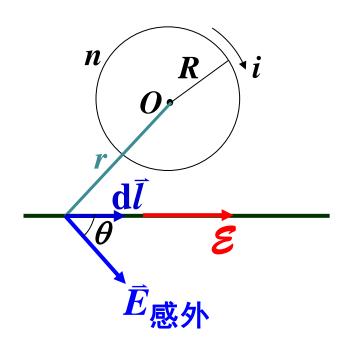
(2) 如图示,过 *O* 点画一条平行长直导线的长直线,它与直导线在两端无限远处闭合,形成一个回路。该回路中的电动势就是长直导线中的电动势。

$$\mathcal{E} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left(\frac{\pi R^2}{2} B \right) = -\frac{1}{2} \pi R^2 \mu_0 n k$$
 \mathcal{E} 的指向如图所示。
 \mathcal{E} 的指向如图所示。

(2) 该问也可以由 $\bar{E}_{ar{\mathbf{G}}^{\mathbf{A}}}$ 的积分求得 $oldsymbol{\mathcal{E}}$:

$$\mathcal{E} = \int E$$
感外 $\cos \theta \, \mathrm{d}l = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} E$ 感外 $\cos \theta \, \frac{r \, \mathrm{d} \, \theta}{\cos \theta}$

$$= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{R^2 \mu_0 nk}{2} d\theta = \frac{1}{2} \pi R^2 \mu_0 nk$$



实际电路中的感生电动势

互感

互感电动势

$$\mathcal{E}_2 = -\frac{\mathrm{d}\Psi_2}{\mathrm{d}t} = -M\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t},$$

$$\mathcal{E}_2 = -\frac{\mathrm{d}\Psi_2}{\mathrm{d}t} = -M\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}, \qquad \mathcal{E}_1 = -\frac{\mathrm{d}\Psi_1}{\mathrm{d}t} = -M\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}$$

互感系数

$$M = -rac{\mathcal{E}_2}{rac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}} = -rac{\mathcal{E}_1}{rac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}}$$
 賞定

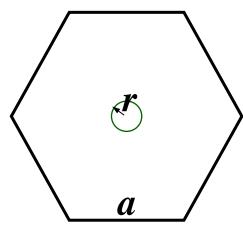
非铁磁质

$$M = \frac{\varPsi_2}{i_1} = \frac{\varPsi_1}{i_2}$$

计算
$$i_1 \rightarrow \Psi_{21} \rightarrow M_{21}$$

在边长为 a 的正六边形线圈的中心放置一半径为 r 的小圆线圈,如图。若两线圈共面同心且 r << a,则两线圈的互感为。

$$M = \frac{B\pi r^2}{I} = \frac{\sqrt{3\mu_0 r^2}}{a}$$



$$B = 6 \times \frac{\mu_0 I}{4\pi \frac{\sqrt{3}a}{2}} (\cos 60^{\circ} - \cos 120^{\circ}) = \frac{\sqrt{3}\mu_0 I}{\pi a}$$

2. <u>自感</u>

● 自感电动势

$$\mathcal{E}_{L} = -\frac{\mathrm{d}\,\Psi}{\mathrm{d}t} = -L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

● 自感系数

$$L = - rac{\mathcal{E}_L}{rac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}}$$
 一普遍之义

非铁磁质

$$L = \frac{\Psi}{i}$$

计算

$$i \longrightarrow \Psi \propto i \longrightarrow L$$

互感线圈的串联

1. 顺接:
$$L = L_1 + L_2 + 2M$$

2. 逆接:
$$L = L_1 + L_2 - 2M$$

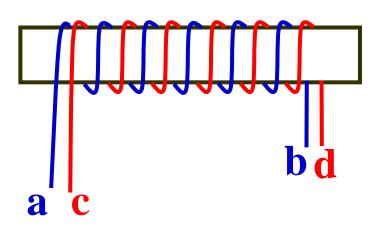


(1)
$$M = 0$$
: $L = L_1 + L_2$

(2) 无漏磁:
$$M=\sqrt{L_1L_2}$$

顺接:
$$L = L_1 + L_2 + 2\sqrt{L_1L_2}$$

逆接:
$$L = L_1 + L_2 - 2\sqrt{L_1L_2}$$



线圈 $ab \cdot cd$ 的自感分别为 $L_1 \cdot L_2$ 。

- 求: (1) 若 b 端和 c 端连接, ad 线圈 的自感。
 - (2) 若 b 端和 d 端连接, ac 线圈的自感。

磁场的能量

● 载流线圈的磁能

$$W_{\rm m} = LI^2/2$$

● 磁能密度

$$w_{\rm m} = \frac{1}{2}BH = \frac{B^2}{2\mu_0\mu_{\rm r}}$$

● 磁场的能量

$$W_{\rm m} = \int_V w_{\rm m} dV$$

位移电流 I_{d} —— 如平行平板电容器中的 I_{d} 计算

位移电流

$$I_{\mathbf{d}} = \frac{\mathbf{d}\boldsymbol{\Phi}_{\mathbf{D}}}{\mathbf{d}t} = \frac{\mathbf{d}}{\mathbf{d}t} \int \vec{D} \cdot \mathbf{d}\vec{S} = \boldsymbol{\varepsilon}_{0} \boldsymbol{\varepsilon}_{\mathbf{r}} \frac{\mathbf{d}}{\mathbf{d}t} \int \vec{E} \cdot \mathbf{d}\vec{S}$$

位移电流密度

$$\vec{j}_{\mathrm{d}} = \frac{\mathrm{d}\bar{D}}{\mathrm{d}t}$$

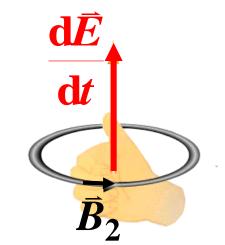
 $\underline{\mathbf{9}}$ $\underline{\mathbf{9}}$ $\underline{\mathbf{9}}$ $\underline{\mathbf{9}}$ $\underline{\mathbf{9}}$ $\underline{\mathbf{9}}$ $\underline{\mathbf{9}}$ $\underline{\mathbf{9}}$

$$\oint_{L} \vec{B}_{2} \cdot d\vec{l} = \mu_{0} \varepsilon_{0} \frac{d \Phi_{e}}{dt} = \mu_{0} \varepsilon_{0} \frac{d}{dt} \int_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

[其中<math>S是闭合回路L为边线的任意形状的面积]

变化的电场产生磁场 \vec{B}_2 与 $\frac{\mathrm{d}\vec{E}}{\mathrm{d}t}$

方向之间的<u>右手螺旋关系</u>



● 恒定电流的安培环路定理

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{\text{int}}$$

● 全电流的安培环路定理

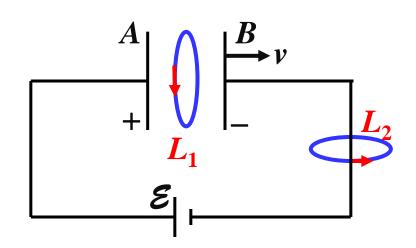
$$\int_{(L)} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \left(I_c + \frac{d}{dt} \int_S \vec{D} \cdot d\vec{S} \right)_{int}$$

[其中 S 是闭合回路 L 为边线的任意形状的面积]

一空气电容器 (忽略边缘效应) 接在电动势为 \mathcal{E} 的电源 (内阻不计) 两端,将 B 极板以匀速率 ν 向右缓慢拉开,如图。当两极板间 距为 x 时,电容器内位移电流密度的大小为 _________; 沿环路 L_1 磁场强度 H 的环流 小于或等于 (填大于、等于或小于) 沿环路 L_2 磁场强度 H 的环流。

$$D = \sigma = \frac{Q}{S} = \frac{\mathcal{E}C}{S} = \frac{\mathcal{E}\varepsilon_0 S/d}{S} = \frac{\varepsilon_0 \mathcal{E}}{d}$$

$$j_{d} = \frac{dD}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\varepsilon_{0} \mathcal{E}}{d} \right) = -\frac{\varepsilon_{0} \mathcal{E}}{x^{2}} v$$



麦克斯韦方程组

$$\vec{E} = \vec{E}_{\mbox{\scriptsize he}} + \vec{E}_{\mbox{\scriptsize ge}}$$

$$\vec{B} = \vec{B}_{\text{11}} + \vec{B}_{\text{12}}$$

1. 电场的高斯定理

$$\oint_{S} \vec{D} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_{0}} \sum q_{0} = \int_{V} \rho_{0} dV$$

说明电场强度 和电荷的联系

2. 磁场的高斯定理(磁通连续原理)

$$\oint_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

自然界中没有单一 的"磁荷"存在

3. 法拉第电磁感应定律

$$\oint_{L} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d \Phi_{m}}{dt} = -\int_{S} \frac{\partial B}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

说明变化磁场 与电场的联系

4. 全电流的安培环路定理

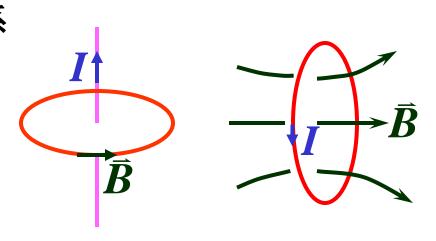
$$\oint_{L} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_{S} \vec{J}_{0} \cdot d\vec{S} + \int_{S} \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

磁场与传导电流及 变化的电场的联系

磁学中的方向问题小结

 $qar{v}$ 、 $ar{r}$ 、 $ar{B}$ 构成右手系

 电流的回转方向与电流 磁场的环绕方向之间的 右手螺旋关系



3. 安培力的方向: $Idar{l} \setminus ar{B} \setminus dar{F}$ 构成右手系

4. 洛伦兹力的方向:

 $qar{v}$ 、 $ar{B}$ 、 $ar{F}$ 构成右手系(要注意 q 为正和负两种情况)

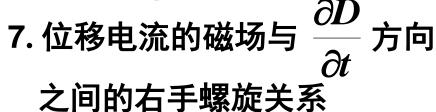
3. 安培力的方向: $Id\bar{l} \setminus \bar{B} \setminus d\bar{F}$ 构成右手系

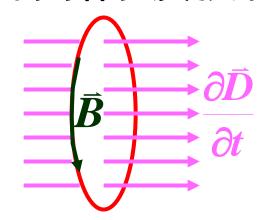
4. 洛伦兹力的方向:

 $qar{v}$ 、 $ar{B}$ 、 $ar{F}$ 构成右手系(要注意 q 为正和负两种情况)

 $\mathbf{d}ar{F}$

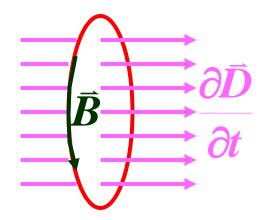
- 5. 通电平面线圈的磁矩 而 和电流回转 方向的右手螺旋关系(\vec{m})的定义)
- 6. 载流平面线圈在磁场中所受磁 力矩的方向: \bar{m} 、 \bar{B} 、 \bar{M} 构成右手系



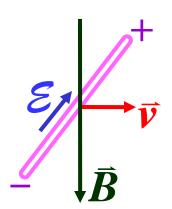




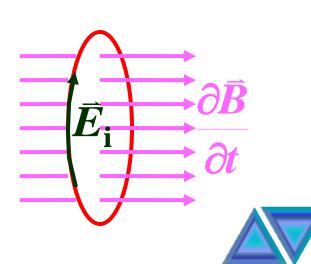
7. 位移电流的磁场与 $\frac{\partial D}{\partial t}$ 方向之间的右手螺旋关系

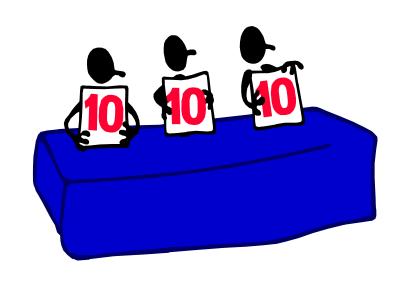


8. 动生电动势的方向: 当导线切割磁力线运动时。 三者 $ar{v}$ 、 $ar{B}$ 、 $ar{\mathcal{E}}$ 方向的右手法则



9. 感生电场的环绕方向与 $\frac{OB}{\partial t}$ 的方向之间的左手螺旋关系









预祝同学们 取得好成绩!

丁克斯斯斯 基本 多种 新叶 克克 克竹 了





